

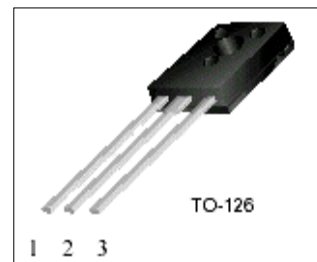
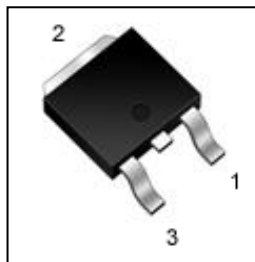
**КТ973А÷Г**

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ ВЧ  
СОСТАВНОЙ ТРАНЗИСТОР**

**оАО. 336.453 ТУ**

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫХ КАСКАДАХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ДЛЯ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- \* Зарубежный аналог КТ973А – **BD876**
- \* Изготавливается в корпусе **КТ-27 (ТО-126)**, **КТ-89 (ДРАК)**
- \* Комплементарная пара – **КТ972 А ÷ Г**



**1 - эмитт. 2 -колл. 3 – база**

**ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Ед измер.	Значение
Напряжение коллектор-база КТ973А, В, Г КТ973Б	Uкб max	В	60 45
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ = 1 кОм) КТ973А, В, Г КТ973Б	Uкэг max	В	60 45
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Iк max	А	2
Импульсный ток коллектора (tu ≤ 10 мкс, Q ≥ 5)	Iки max	А	4
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Ткорп. = -45 ÷ +25 °С	Рк max	Вт	8
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тсреды. = 25 °С	Рк max	Вт	1.25
Температура перехода	Tj	°С	150

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Токр.ср.=25°С )**

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектор-эмиттер КТ973А, В КТ973Б	Iкэг	мА	Uкэ = 60В, Rэб = 1 кОм Uкэ = 45В, Rэб = 1 кОм		1.0 1.0
Статический коэффициент передачи тока КТ973А, Б КТ973В	h <sub>21E</sub>		Uкб = 3 В, Iэ = 1 А, f = 50 Гц	750 750	5 000
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ(нас)	В	Iк = 500 мА, Iб = 50 мА		1.5
Напряжение насыщения база-эмиттер	Uбэ(нас)	В	Iк = 500 мА, Iб = 50 мА		2.5
Время -рассасывания	tрас.	нс	Iб1= Iб2= 50 мА, Q ≥ 50 ti=30 мкс, Iк = 500 мА,		200

**220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"**  
**Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32**  
**E-mail:market@transistor.com.by; http://www.transistor.by**